1.CMOS结构的LDO线性稳压器，其特征在于，包括：偏置电路模块、带隙基准源电路模块、误差放大器电路模块、比较器电路模块以及输出电路模块；

所述偏置电路模块为后级电路提供合适的偏置电压；

所述带隙基准源电路模块为后级电路提供稳定的电压并作为新型LDO的输入级；

所述误差放大器电路模块，用于比较输出反馈取样信号与基准电压，并控制后级电路的工作状态，使输出保持稳定；

所述比较器电路模块输出端与双掷开关相连，控制LDO的输出；

所述输出电路模块，由功率调整管、双掷开关和负载共同构成；

所述偏置电路模块采用自偏置结构，给整个电路提供可靠而稳定的偏置电压；

所述带隙基准源电路模块采用β二阶补偿带隙基准电路结构，为后级电路提供与温度无关且稳定的基准电压；

所述误差放大器电路模块采用折叠式共源共栅结构；

所述比较器电路模块采用两级运放结构；

所述偏置电路模块包括：PMOS管P1、P2，NMOS管N1、N2以及电阻R，NMOS管N1、N2形成电流镜，PMOS管P1、P2和R构成对数电流源，偏置电路模块作为偏置电路输出端；

所述带隙基准源电路模块包括：PMOS管P1、P2、P3、P4，NMOS管N1、N2、N3、N4、N5，三极管NPN1、NPN2、NPN3，电容Cc以及电阻R1、R2；VIN是输入负电源，GND是接地线，PMOS管P1、P2、P3、P4和NMOS管N1、N2构成运放单元，通过反馈环路使节点A和B的电位相等；电容Cc对环路起密勒补偿作用，PMOS管P2是启动管；电阻R1、R2，三极管NPN1、NPN2和NMOS管N3、N4、N5构成带隙基准核，三极管NPN1和NPN2的个数比是7:1；NMOS管N3，N4，N5构成1:1:1的镜像电流源，漏极电流ID3＝ID4＝ID5＝ID，三极管NPN3起减小NMOS管N3沟道长度调制效应的作用；REF\_OUT为基准源的输出端。

2.如权利要求1所述的CMOS结构的LDO线性稳压器，其特征在于，所述比较器电路模块通过选择双掷开关SW的节点A、B，达到LDO输出可调的目的。